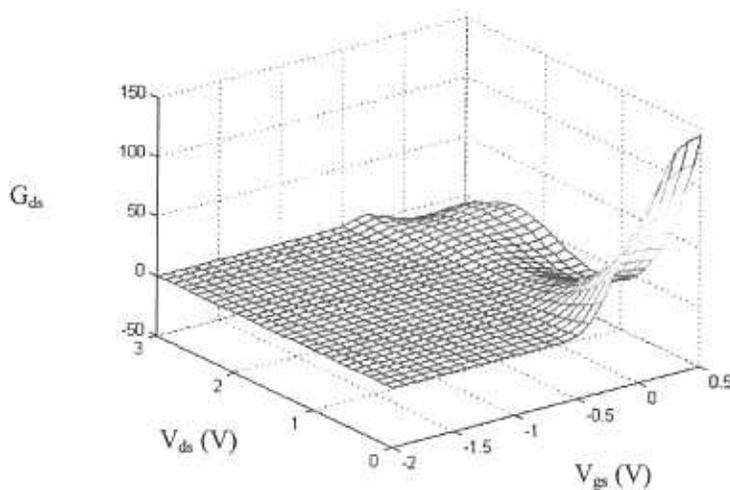


Tras proceder a ajustar los parámetros, se obtuvieron los siguientes resultados:

Parámetros	Parámetros de F_1	Parámetros de A_1	Parámetros de A_2	Parámetros de A_3
F_{cut}	72.3347	1.8228	1.0727	0.1866
P_1	2.5722	0.0005	0.2730	-0.0935
P_2	-0.3162	0.1463	0.0760	-0.0231
P_3	10.0462	0.0108	1.4973	3.3724
V_{cut}	-0.0575	0.0293	0.0759	0.1230
λ	-	0.2483	0.0079	0.2893

A continuación se muestran los resultados obtenidos gráficamente:



Si comparamos los resultados obtenidos con los que se deberían obtener, se puede ver que este modelo no es capaz de aproximar correctamente la función G_{ds} de este transistor.

5.5.2 Transistor HEMT modelo foundry ED02AH con $W=6 \times 50$

A continuación se muestran los valores de G_{ds} en función de V_{gs} y V_{ds} para este transistor: